

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 4 区分
【発行日】平成 17 年 9 月 15 日 (2005.9.15)

【公開番号】特開 2002-294483 (P2002-294483A)
【公開日】平成 14 年 10 月 9 日 (2002.10.9)
【出願番号】特願 2001-322035 (P2001-322035)
【国際特許分類第 7 版】

C 2 5 D 3/38
C 2 5 D 7/12
H 0 1 L 21/288

【F I】

C 2 5 D 3/38
C 2 5 D 7/12
H 0 1 L 21/288 E

【手続補正書】
【提出日】平成 17 年 4 月 1 日 (2005.4.1)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

0.5 μ m 未満のサイズを有するアパーチャを含有するウェハ上に配置された、実質的に不連続の無い金属シード層を提供する方法であって、該方法が、ウェハ上に配置された不連続性を有する金属シード層を、1 以上の銅イオン源、1 以上の促進剤、及び酸性電解質を含み、銅イオンが 10 g / L までの量で存在する電気めっき浴と接触させる工程を含む、該方法。

【請求項 2】
銅イオンが 8 g / L までの量で存在する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】
電解質が 70 g / L までの添加酸を含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】
アパーチャが 0.18 μ m 以下のサイズを有する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】
請求項 1 に記載の方法に従って調製された金属シード層を有するウェハを提供する工程を含む、集積回路を製造する方法。